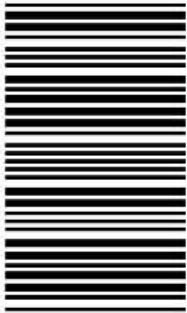


کد کنترل

337

E



337E

دفترچه شماره (1)

صبح جمعه

۹۸/۱۲/۹



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌متمرکز) - سال ۱۳۹۹

رشته فناوری نانو - نانوالکترونیک - کد (۲۳۶۴)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: ریاضی و فیزیک (ریاضی عمومی (۱ و ۲)، ریاضی فیزیک (۱ و ۲)، فیزیک پایه (۱ و ۲)) - مبانی نانو تکنولوژی - ادوات نیمه‌هادی پیشرفته	۴۵	۱	۴۵

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و یا متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

۱۳۹۹

پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۲

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) - کد (۲۳۶۴) 337E

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، به منزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سؤالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤالات و پائین پاسخنامه ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

۱- اگر A عددی ثابت باشد، آنگاه $\lim_{t \rightarrow 1^+} (1 - (t-1)A)^{\frac{2}{t^2-1}}$ کدام است؟

(۱) e^A

(۲) e^{-A}

(۳) e^{2A}

(۴) e^{-2A}

۲- فرض کنید $f(x) = \frac{(x+1)^2(x+2)^3}{(x+4)^2(x+8)^2}$ باشد. در این صورت $f'(0)$ کدام است؟

(۱) ۵

(۲) -۵

(۳) $\frac{20}{3}$

(۴) $-\frac{5}{4}$

۳- حاصل $\int_1^e \cos(\ln x) dx$ کدام است؟

(۱) $\cos(\sinh) + \sin(\cosh)$

(۲) $\cos(\cosh) + \sin(\sinh)$

(۳) $\cos(\sinh) - \sin(\cosh)$

(۴) $\cos(\cosh) - \sin(\sinh)$

۴- اگر $\int_0^x \ln t dt = x \ln(\alpha x)$ ، $x \neq 0$ مقدار α کدام است؟

(۱) ۰

(۲) ۱

(۳) e

(۴) e^{-1}

۵- طول کمانی از خم به معادله $\begin{cases} x = e^t \cos t \\ y = e^t \sin t \end{cases}$ بین دو نقطه $t = 0$ و $t = 4$ ، کدام است؟

(۱) $e^4 - 1$

(۲) $2(e^4 - 1)$

(۳) $\sqrt{2}(e^4 - 1)$

(۴) $\sqrt{2}(e^4 + 1)$

۶- معادله خط قائم بر رویه $z = e^y + 1 + \arctan(2z)$ ، در نقطه $(1, \ln 2, 0)$ ، کدام است؟

(۱) $2z = x - 1, z + y = \ln 2$

(۲) $2z = 2x - 2, z + y = \ln 2$

(۳) $z = x - 1, z + y = 2$

(۴) $z - y = \ln \frac{e}{2}, z + x = 1$

۷- اگر تابع $f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{-(x^2 + y^2)}$ در نقطه (a, b) به بیشترین مقدار خود برسد، آنگاه کدام مورد درست است؟

(۱) $a = b$

(۲) $ab = 0$

(۳) $a = -b = 1$

(۴) $a^2 + b^2 = 1$

۸- فرض کنید $x = u + v$ ، $y = u^2 + v^2$ و $z = u^3 + v^3$ باشند، $\frac{\partial z}{\partial x}$ کدام است؟

(۱) $\frac{3uv(u+v)}{(u-v)}$

(۲) $\frac{3uv(v+u)}{(v-u)}$

(۳) $\frac{3uv(u-v)}{(u+v)}$

(۴) $\frac{3uv(v-u)}{(v+u)}$

۹- اگر $D = \{(x, y), x > 0 \text{ و } y > 0, x + y < 1\}$ باشد، مقدار $\iint_D e^{\frac{x-y}{x+y}} dx dy$ ، کدام است؟

(۱) $\frac{1}{2}(e + e^{-1})$

(۲) $\frac{1}{2}(e - e^{-1})$

(۳) $\frac{1}{4}(e + e^{-1})$

(۴) $\frac{1}{4}(e - e^{-1})$

- ۱۰- در یک مدل از هاله خورشیدی رابطه شارش گرمای $\vec{V} \cdot (k \vec{\nabla} T) = 0$ برقرار است که k رسانندگی گرمایی با T^3 متناسب است. با فرض آن که T با r^n متناسب باشد که r فاصله از مرکز خورشید است، مقدار n کدام است؟

(۱) $-\frac{1}{4}$

(۲) $\frac{1}{4}$

(۳) $-\frac{1}{5}$

(۴) $\frac{1}{5}$

- ۱۱- اگر در مختصات استوانه‌ای، بردار \vec{B} به شکل $\vec{B} = f(\rho) \hat{\phi}$ تعریف شده باشد، حاصل عبارت $(\vec{B} \cdot \vec{\nabla}) \vec{B}$ کدام است؟ $(\hat{\rho}, \hat{\phi}, \hat{k})$ بردارهای یگانه در مختصات استوانه‌ای (ρ, ϕ, z) هستند.

(۱) $\frac{1}{\rho} f''(\rho) \hat{\phi}$

(۲) $\frac{1}{\rho} f''(\rho) \hat{\rho}$

(۳) $-\frac{1}{\rho} f''(\rho) \hat{\rho}$

(۴) $-\frac{1}{\rho^2} f''(\rho) \hat{\phi}$

- ۱۲- کدام ماتریس هم یکانی (Unitary) و هم هرمیتی است؟

(۲) $\begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix}$

(۱) $\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$

(۴) $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$

(۳) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ i & 0 \end{pmatrix}$

- ۱۳- اگر A و B دو ماتریس $N \times N$ وارون پذیر باشند که در رابطه $AB = -BA$ صدق می‌کنند، در آن صورت کدام عبارت درست است؟

(۱) به ازای هر مقدار متناهی N همواره $\text{Tr}A = \text{Tr}B = 0$

(۲) به ازای مقادیر زوج N همواره $\det A = \det B = 0$

(۳) فقط به ازای مقادیر زوج N دترمینان ماتریس AB صفر است.

(۴) فقط به ازای مقادیر فرد N تریس ماتریس AB صفر است.

- ۱۴- حاصل انتگرال $\oint_C \frac{4z-3}{z(z-2)} dz$ که $z = x + iy$ و C دایره‌ای به مرکز مبدأ مختصات و شعاع ۳ است، کدام است؟

(۱) $4\pi i$

(۲) $8\pi i$

(۳) $10\pi i$

(۴) $16\pi i$

۱۵- معادله دیفرانسیل مرتبه دوم $\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} = E u(x,y)$ که در آن E مقداری ثابت است در نظر

گرفته شود. کدام تابع می تواند جواب معادله دیفرانسیل فوق باشد؟ (A و B و x_0 و y_0 مقادیر ثابتی هستند).

$$u(x,y) = \cos(\Lambda(x+x_0)) \sin(B(y+y_0)) \quad (1)$$

$$u(x,y) = \sin(A(x+x_0)) \cos(B(y+y_0)) \quad (2)$$

$$u(x,y) = \sin(\Lambda(x+x_0)) \cos(B(y+y_0)) \quad (3)$$

$$u(x,y) = \sin(A(x+x_0)) \sin(B(y+y_0)) \quad (4)$$

۱۶- با توجه به تعریف توابع بسل $J_n(x)$ توسط تابع مولد $\sum_{n=-\infty}^{\infty} t^n J_n(x) = e^{\frac{x}{2}(t-\frac{1}{t})}$ ، کدام رابطه در مورد توابع

بسل نادرست است؟

$$x^2 \frac{d^2 J_n(x)}{dx^2} + x \frac{dJ_n(x)}{dx} + (x^2 - n^2) J_n(x) = 0 \quad (1)$$

$$J_n(x) = \sum_{s=0}^{\infty} \frac{(-1)^s}{s!(n+s)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{n+2s} \quad (2)$$

$$J_{n+1}(x) + J_{n-1}(x) = \frac{2n}{x} J_n(x) \quad (3)$$

$$\frac{d}{dx} J_n(x) = -J_{n-1}(x) \quad (4)$$

۱۷- معادله دیفرانسیل $C_2 \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + C_1 \frac{dx(t)}{dt} + C_0 x(t) = f(t)$ را در نظر بگیرید که C_1 ، C_2 و C_0 ضرایبی

ثابت هستند. تبدیل فوری $x(t)$ که به شکل $\tilde{x}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dt x(t) e^{-i\omega t}$ تعریف می شود، در کدام رابطه

صدق می کند؟ ($\tilde{f}(\omega)$ تبدیل فوری $f(t)$ است).

$$\tilde{x}(\omega) = \frac{-\tilde{f}(\omega)}{C_2 \omega^2 - iC_1 \omega + C_0} \quad (1)$$

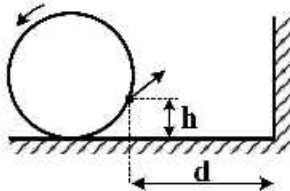
$$\tilde{x}(\omega) = \frac{\tilde{f}(\omega)}{-C_2 \omega^2 + iC_1 \omega + C_0} \quad (2)$$

$$\tilde{x}(\omega) = \frac{-\tilde{f}(\omega)}{C_2 \omega^2 + iC_1 \omega + C_0} \quad (3)$$

$$\tilde{x}(\omega) = \frac{\tilde{f}(\omega)}{-C_2 \omega^2 + iC_1 \omega + C_0} \quad (4)$$

۱۸- گلوله‌ای از بتونه خیس بر پیرامون چرخ به شعاع 50 cm قرار دارد. چرخ در صفحه قائم حول محور تقارن خود با بسامد زاویه‌ای $20 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ در جهت پاد ساعتگرد می‌چرخد. اگر صفحه چرخ به صفحه ساعت تشبیه شود، وقتی بتونه به وضعیت عدد ۴ برسد از پیرامون چرخ جدا می‌شود. در این لحظه ارتفاع بتونه از کف زمین $h = 1/5\text{ m}$ و فاصله آن از دیوار قائم جلوی خود $d = 4\text{ m}$ است. بتونه تقریباً در ارتفاع چند متری از سطح زمین با دیوار برخورد می‌کند؟

$$(g = 9/8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$$



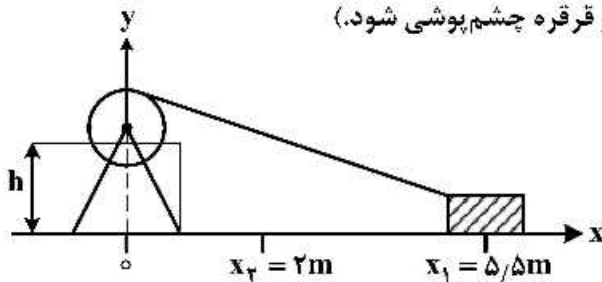
۳/۸ (۱)

۵/۳ (۲)

۶/۹ (۳)

۷/۴ (۴)

۱۹- در شکل زیر جعبه m روی سطح افقی بدون اصطکاک در امتداد محور x می‌تواند بلغزد. این جعبه توسط نخ بدون جرمی که به بولی یک موتور واقع در ارتفاع $h = 1/5\text{ m}$ متصل است، از نقطه $x_1 = 5/5\text{ m}$ به نقطه $x_2 = 2\text{ m}$ منتقل می‌شود. کشش نخ در این جابه‌جایی مقدار ثابت 50 N است. انرژی جنبشی جعبه در این جابه‌جایی تقریباً چند ژول تغییر کرده است؟ (از جرم و اصطکاک در محور فرجه چشم‌پوشی شود.)



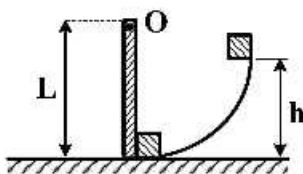
۱۱۱ (۱)

۱۶۰ (۲)

۱۶۹ (۳)

۱۷۵ (۴)

۲۰- مکعب کوچکی به جرم m مطابق شکل روی سطح بدون اصطکاک از ارتفاع h از حالت سکون به حرکت درمی‌آید و در نقطه پایین مسیر به انتهای میله یکنواختی به جرم M و طول L برخورد کرده و به آن می‌چسبد. میله می‌تواند آزادانه حول نقطه آویز O دوران کند. تندی خطی مجموعه درست پس از لحظه برخورد کدام است؟



$\frac{1}{1 + \frac{M}{m}} \sqrt{2gh}$ (۱)

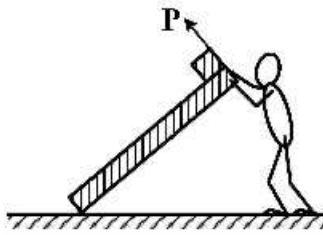
$\frac{1}{1 + \frac{M}{2m}} \sqrt{2gh}$ (۲)

$\frac{1}{1 + \frac{M}{3m}} \sqrt{2gh}$ (۳)

$\frac{1}{1 + \frac{M}{12m}} \sqrt{2gh}$ (۴)

پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

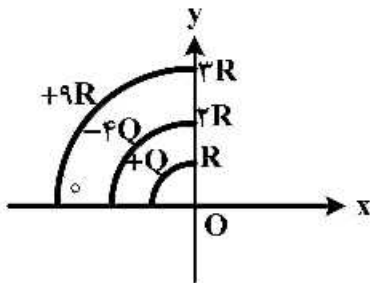
۲۱- میله آهنی یکنواختی به طول ۳m و وزن ۶۰۰N را کارگری از روی زمین بلند می کند. در یک لحظه معین یک سر میله روی زمین و سر دیگر آن در ارتفاع ۱/۵ متری از سطح زمین قرار دارد. اگر در این وضعیت، میله ساکن باشد و کارگر نیروی \vec{P} را عمود بر میله وارد کند، اندازه نیروی P چند نیوتن است؟



- (۱) ۱۵۰
- (۲) ۳۰۰
- (۳) $۵۰\sqrt{۳}$
- (۴) $۱۵۰\sqrt{۳}$

۲۲- بار الکتریکی روی هر یک از سه ربع دایره هم مرکز مطابق شکل زیر به طور یکنواخت توزیع شده است. اگر $Q = ۵\mu C$ و $R = ۵cm$ باشد، میدان الکتریکی کل در نقطه O (مرکز ربع دایره ها) بر حسب نیوتن بر متر کدام است؟

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \frac{N.m^2}{C^2}$$

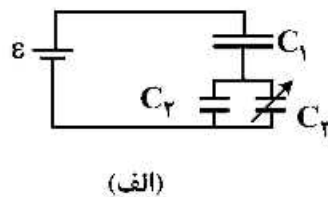
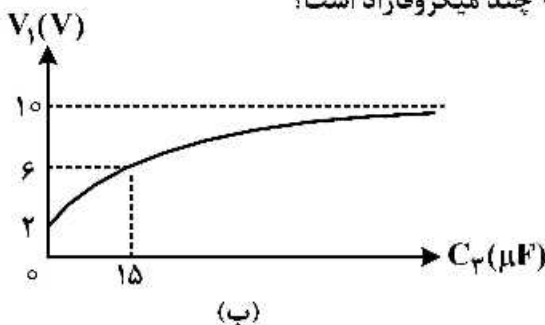


- (۱) $۱/۱۴ \times ۱۰^۵ (\hat{i} - \hat{j})$
- (۲) $۴/۵ \times ۱۰^۷ (\hat{i} - ۲\hat{j})$
- (۳) $۵/۷ \times ۱۰^۵ (\hat{i} - \hat{j})$
- (۴) $۶/۸ \times ۱۰^۷ (۲\hat{i} - \hat{j})$

۲۳- یک دو قطبی الکتریکی با گشتاور دو قطبی $\vec{p} = (-۴\hat{i} + ۶\hat{j})(۱۰^{-۲۲} C.m)$ در میدان الکتریکی $\vec{E} = (-۲۰۰\hat{i} + ۵۰\hat{j}) \frac{N}{C}$ قرار دارد. اگر یک عامل خارجی این دو قطبی را تا وضعیتی بچرخاند که گشتاور دو قطبی آن به شکل $\vec{p} = (۶\hat{i} + ۴\hat{j})(۱۰^{-۳۰} C.m)$ در آید، کار انجام شده توسط این عامل خارجی در این فرایند بر حسب الکترون ولت کدام است؟

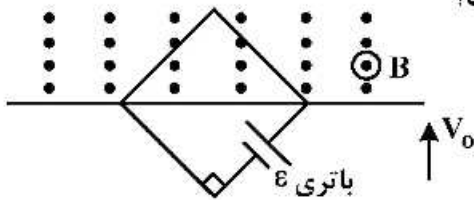
- (۱) -۰/۷
- (۲) +۰/۷
- (۳) +۱/۳
- (۴) -۱/۳

۲۴- در شکل (الف) خازن شماره ۳ یک خازن متغیر است و در شکل (ب) نمودار V_1 ، اختلاف پتانسیل دو سر خازن ۱، بر حسب ظرفیت C_3 رسم شده است. مقدار ظرفیت خازن C_1 چند میکروفاراد است؟



- (۱) ۳
- (۲) ۳/۶
- (۳) ۵
- (۴) ۱۲

۲۵- یک حلقه سیمی مربعی شکل به ضلع 5m عمود بر یک میدان مغناطیسی یکنواخت و ثابت 2T قرار دارد. در لحظه $t = 0$ نصف مساحت حلقه در میدان قرار دارد. این حلقه شامل یک باتری 20V است. مطابق شکل حلقه با سرعت ثابت $V_0 = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ در راستای عمود بر قطرش به سمت ناحیه‌ای که میدان وجود دارد حرکت می‌کند. ۳ ثانیه پس از شروع حرکت، اندازه نیروی محرک خالص در سیم چند ولت است؟

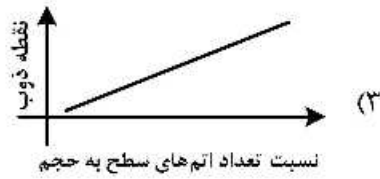
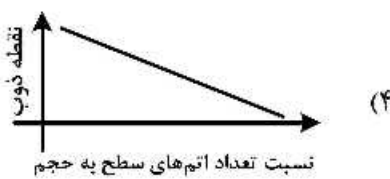


- (۱) ۳/۴
- (۲) ۱۶/۶
- (۳) ۱۷/۲
- (۴) ۲۳/۴

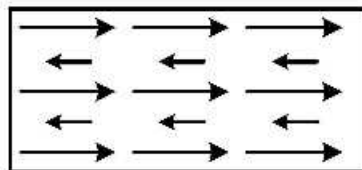
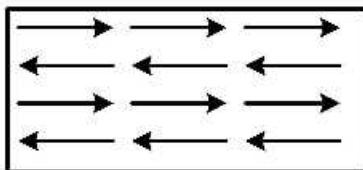
۲۶- جهت بررسی خواص یک لایه عایق از کدام آنالیز نمی‌توان استفاده کرد؟

- (۱) AFM
- (۲) STM
- (۳) SEM
- (۴) TEM

۲۷- در یک نانو ذره با افزایش اتم‌های سطح به حجم، دمای ذوب ماده چگونه تغییر می‌کند؟



۲۸- اگر جهت فلش (پیکان) نشان‌دهنده جهت حوزه‌های مغناطیسی باشد، دو ماده به ترتیب دارای چه خاصیت مغناطیسی هستند؟



(a)

(b)

- (۱) Ferrimagnetic
- (۲) Paramagnetic
- (۳) Ferromagnetic
- (۴) Paramagnetic
- (a) Antiferromagnetic
- (b) Superparamagnetic

۲۹- فرض کنید به نانوذرات رشته‌های پلی‌نوکلئوتیدی با ترتیب‌های مختلف متصل شده‌اند. کدام دو نانوذره در نتیجه جفت شدن بازهای DNA می‌توانند به یکدیگر نزدیک شوند؟

- (۱) AGCTA CTAGC
- (۲) AUCGA GCUAG
- (۳) ATCGA GCTAG
- (۴) ATGGA TACCT

- ۳۰- فرض کنید مجموعه‌ای از نانوذرات تولید شده‌اند. برای کاهش انرژی سطحی آن‌ها چه روشی را پیشنهاد می‌کنید؟
 (۱) آگلومره شدن نانوذرات
 (۲) ایجاد ساختارهای یک بعدی از نانوذرات
 (۳) کوچک کردن سایز نانوذرات
 (۴) ایجاد ساختارهای با نظم هگزاگونال
- ۳۱- در یک میکروسکوپ روبشی تونلی (STM) اندازه جریان تونل زنی با افزایش ولتاژ بایاس و فاصله بین تیپ و سطح نمونه به ترتیب چگونه تغییر خواهد کرد؟
 (۱) افزایش نمایی - کاهش خطی
 (۲) افزایش خطی - کاهش نمایی
 (۳) کاهش نمایی - افزایش خطی
 (۴) کاهش خطی - افزایش نمایی
- ۳۲- چگالی حالات با افزایش انرژی در هر محدوده از انرژی مجاز در یک سیم کوانتومی چه تغییری می‌کند؟
 (۱) افزایش می‌یابد.
 (۲) کاهش می‌یابد.
 (۳) ثابت می‌ماند.
 (۴) وابسته به طول نانوسیم است.
- ۳۳- کدام روش مشخصه‌یابی بر مبنای اندازه‌گیری جذب توسط ارتعاشات ساختار مولکولی قرار دارد؟
 (۱) XRD
 (۲) TEM
 (۳) FTIR
 (۴) UV-Vis spectroscopy
- ۳۴- فلز مس با تراز فرمی برابر ۷ الکترون ولت را در نظر بگیرید. انتظار دارید یک ذره مس در حدود چه ابعادی تبدیل به یک نقطه کوانتومی شود؟

$$\text{بار الکترون} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\text{جرم الکترون} = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

- (۱) ۵ انگستروم (۲) ۵ نانومتر (۳) ۱۰ نانومتر (۴) ۵۰ نانومتر

- ۳۵- زمانی که دو ذره با شعاع متفاوت (یکی بسیار بزرگتر از دیگری) داخل حلال قرار داده می‌شوند، حلالیت ذره کوچک‌تر بیشتر از ذره بزرگ بوده و در نتیجه ذره کوچک‌تر به‌طور مداوم کوچک‌تر شده و ذره دیگر بزرگ‌تر می‌گردد. نام این پدیده کدام است؟

- (۱) تراکم (۲) آگلومراسیون (۳) رشد استوالد (۴) رشد کلوتیدی

- ۳۶- با در نظر گرفتن مقدار تابع کار فلزات طلا، نقره، آلومینیوم و کروم مطابق جدول زیر، اتصال کدام فلز به سیلیکون، سد شاتکی کمتری خواهد داشت؟

	تابع کار (الکترون ولت)		الکترون خواهی (الکترون ولت)	گاف انرژی (الکترون ولت)
Ag	۴/۲۶	Si	۴/۵۱	۱/۱
Au	۵/۱			
Al	۴/۲۸			
Cr	۴/۵			

- (۱) Al (۲) Ag (۳) Au (۴) Cr

پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

۳۷- در ترانزیستور n-MOS در دمای $T = 300K$ و غلظت آلاینده $N_D = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ ، ضخامت اکسید برابر با 442 \AA و ثابت دی الکتریک آن ۴ است. ظرفیت خازنی معادل اکسید کدام است؟

- (۱) $4 \mu\text{F}$
- (۲) $4 \frac{\text{F}}{\text{m}^2}$
- (۳) $0.08 \frac{\mu\text{F}}{\text{cm}^2}$
- (۴) $100 \frac{\text{F}}{\mu\text{m}^2}$

۳۸- می خواهیم با استفاده از یک نیمه هادی سیلیکون به طول $100 \mu\text{m}$ و سطح مقطع $100 \mu\text{m}^2$ مقاومتی بسازیم که در برابر اعمال ولتاژ ۴ ولت، جریان 0.1 mA را عبور دهد. مقدار غلظت آلاینده مورد نیاز (نوع p) کدام است؟

$$\mu_p = 400 \frac{\text{cm}^2}{\text{V.s}}$$

- (۱) $3.9 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$
- (۲) $3.9 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$
- (۳) $7.8 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$
- (۴) $7.8 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$

۳۹- فرض کنید یک آشکارساز نوری با ماده نیمه هادی CdS با گاف انرژی 2.4 الکترون ولت با ابعاد $4 \times 10^{-2} \text{ cm}^2$ در اختیار داریم. اگر این آشکارساز در معرض نوری با طول موج 400 نانومتر و شدت 20 وات بر مترمربع قرار گیرد، منجر به تولید چه جریانی می شود؟

- (۱) 1 میکرو آمپر
- (۲) 10 میکرو آمپر
- (۳) 2.5 میکرو آمپر
- (۴) 25 میکرو آمپر

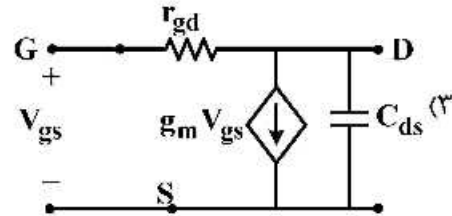
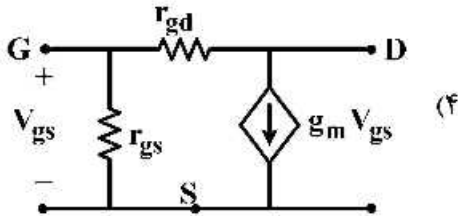
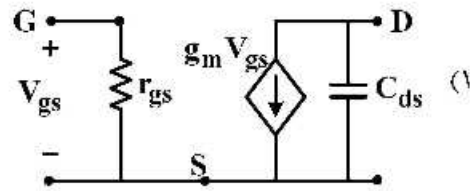
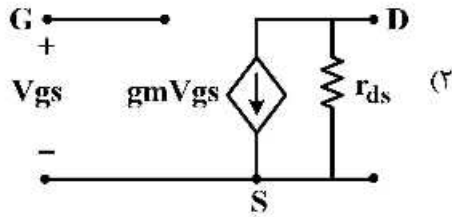
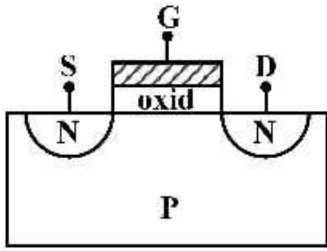
۴۰- در یک نیمه هادی نوع n، غلظت الکترون ها به صورت خطی از $2 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ تا $5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ در فاصله $1/5 \text{ mm}$ تغییر می کند. با در نظر گرفتن ضریب نفوذ الکترون ها $D_n = 200 \frac{\text{cm}^2}{\text{s}}$ ، مقدار جریان نفوذ کدام است؟

- (۱) $16 \mu\text{A}$
- (۲) $32 \mu\text{A}$
- (۳) $16 \frac{\text{A}}{\text{cm}^2}$
- (۴) $32 \frac{\text{A}}{\text{cm}^2}$

۴۱- مقدار مقاومت دیود در نقطه کار $I_D = 2/5 \text{ mA}$ و $V_D = 1V$ در دمای $300K$ چند Ω است؟

- (۱) 0.5
- (۲) 1
- (۳) 5
- (۴) 10

۴۲- کدام شکل نشان دهنده مدل ساده شده مداری قطعه زیر است؟



۴۳- یک نقطه کوانتومی را در نظر بگیرید که در نتیجه واهلش الکترون تراز هدایت فوتونی با فرکانس ۶۰۰ تراهرتز نشر می کند. گاف انرژی این نقطه کوانتومی چند الکترون ولت است؟

(۲) ۱

(۱) ۲/۵

(۴) ۵/۱

(۳) ۵/۲۵

۴۴- یک نقطه کوانتومی از جنس گالیوم آرسناید GaAs با ظرفیت خازنی $7/3 \times 10^{-18}$ فاراد در نظر بگیرید. اگر از این نانو ذره در یک ترانزیستور تک الکترونی استفاده شود، چه ولتاژی منجر به تونل زنی خواهد شد؟

(۲) ۱۱۰ ولت

(۱) ۱۱ ولت

(۴) ۱۱۰ میلی ولت

(۳) ۱۱ میلی ولت

۴۵- در یک ترانزیستور n-MOS ایدئال نسبت عرض کانال به طول گیت $\left(\frac{W}{L}\right)$ چه مقدار باشد تا

Transconductance در ناحیه اشباع g_{ms} برابر با ۵/۵ms باشد؟

$$I_D(\text{sat}) = \frac{W\mu_n C_{ox}}{2L} (V_{GS} - V_T)^2$$

$$C_{ox} = 8 \times 10^{-8} \frac{F}{\text{cm}^2}$$

$$V_T = 0.7V$$

$$V_{GS} = 4V$$

$$\mu_n = 700 \frac{\text{cm}^2}{V.s}$$

(۲) ۳/۷

(۱) ۲/۷

(۴) ۳۷

(۳) ۲۷

